

ملاحظات انجام پروژه و ارسال آن:

پروژه باید در گروههای دو نفری انجام پذیرد.

پروژه باید در قالب یک فایل ZIP ایمیل شود. ا<mark>سم این فایل و عنوان ایمیل</mark> را <u>حتما</u> به صورت زیر قرار دهید، در غیر اینصورت پروژه شما بررسی نخواهد شد.

نام افراد گروه-E1-P2-Ansari-Azadi : نام افراد گروه

در داخل فایل زیپ فوق، فقط یک فایل PDF به همراه تمامی فایلهای شبیهسازی قرار داده شود. در فایل PDF مذکور، تمامی جزئیات و مراحل طراحی، گام به گام توضیح داده شده و تمامی مدارهای طراحی شده و نتایج شبیهسازی آن به طور کامل گزارش شود. در تمامی موارد خواسته شده هم تحلیل تئوری و هم شبیهسازی و هم مقایسه این دو مورد نیاز است. شکلها را طوری قرار دهید که اعداد کاملا واضح و خوانا باشد. به همراه فایل PDF کلیه فایلهای شبیهسازی نیز ارسال شود.

توجه فرمایید که به گزارش های مشابه نمرهای تعلق نخواهد گرفت.

برای اطمینان از این که ایمیل ارسالی شما به دست بنده رسیده است، پس از ارسال ایمیل شما، ایمیلی به صورت خود کار، مبنی بر اینکه فایل شما توسط بنده دریافت شده است، از ایمیل بنده ارسال خواهد شد. در صورتی که این ایمیل را دریافت نکردید، لطفا ایمیل خود را مجددا ارسال فرمایید.

m.r.ashraf@chmail.ir

لطفا پروژههای خود را فقط به این ایمیل ارسال فرمایید:

لطفا به <u>ساعت ار</u>سال پروژه دقت فرمایید. ارسال با تأخیر پروژه، منجر به کسر نمره قابلتوجهی خواهد شد.

این پروژه ممکن است ارائه آنلاین داشته باشد. در این خصوص اطلاعرسانی خواهد شد.

ملاحظات گزارشنویسی:

گزارش نویسی بخش مهمی از انجام هر پروژه است. در نوشتن گزارش پروژه دقت لازم را بهعمل آورید.

هر گزارش باید دارای صفحات و موضوعاتی به شرح و ترتیب زیر باشد:

۱- صفحه اول شامل نام و نشان مؤسسه وابسته، موضوع پروژه، اسم اعضای گروه و تاریخ.

٢- فهرست مطالب

۳- مقدمه: در مقدمه نهایتا در یک صفحه به توضیح کلیات پروژه و هدف از انجام پروژه بپردازید.

۴- متن گزارش: باید شامل تحلیل تئوری و شبیهسازی و مقایسه این دو باشد. تمامی شکلها باید دارای زیرنویس مناسب و جدولها باید دارای بالانویس باشند. از قراردادن شکل بدون توضیح در متن خودداری کنید. شکلها و جدولها باید خوانا باشند. اگر عکسی در متن می گذارید، عکس باید به اندازه کافی خوانا باشد. تمامی صفحات متن باید دارای شماره صفحه باشد. در نوشتن متن گزارش از نوع قلم (فونت) مناسب (مثل نازنین یا زر در فارسی و ۱۲ سب در Roman در لاتین) و اندازه مناسب (۱۴ در فارسی و ۱۲ در لاتین) استفاده نمایید. همچنین حاشیه گذاری مناسب در متن فراموش نشود. صفحات گزارش را با اندازه A4 انتخاب کنید.

۵- نتیجه گیری: نتیجه حاصل از انجام پروژه در حد یک صفحه

۶- مراجع (در صورت استفاده)

نمونههایی از گزارشهای نسبتا مناسب در ترمهای قبل، پیوست شدهاند.

نکاتی در مورد شبیهسازی:

در طراحی ترانزیستورها، لزوماً از پارامترهای زیر استفاده نمایید.

$$BJT: \beta = 100, |V_{BE}| = 0.7, |V_{CE,sat}| = 0.2, V_A = 100V$$

در شبیه سازی مدارات خود برای استفاده از ترانزیستورهای BJT می توانید از مدل BC107 یا Q2n2222 برای npn و BJT می توانید از مدل pnp یا BC177 برای pnp برای pnp استفاده نمایید. برای تنظیم پارامترهای ترانزیستور مطابق اعداد بالا به طریق زیر عمل کنید:

بر روی ترانزیستور کلیک سمت راست کرده و گزینه "edit pspice model" را انتخاب نمایید. در فایل باز شده پارامتر Baf معادل Vaf و Vaf معادل Vaf ترانزیستور میباشد. مقدار این پارامترها را مطابق اعداد مشخص شده در بالا تغییر داده و این فایل را ذخیره نمایید. اکنون ترانزیستور شما ترانزیستوری مطابق با پارامترهای فوق است. (امتحان کنید!) اگر در طراحی تقویت کننده به خازن نیاز دارید، مقدار خازنها را ۱۰ یا ۱۰۰ میکروفاراد درنظر بگیرید. همچنین فرکانس سیگنال ورودی در تقویت کننده را حدود ۱۰ کیلوهرتز می توانید فرض کنید.

پروژه دوم درس الکترونیک ۱

✓ هدف از انجام پروژه

آشنایی با نحوه طراحی یک تقویت کننده تک-طبقه برای یک کاربرد مشخص

آشنایی با شبیهسازی تقویت کننده و نحوه بهدست آوردن بهره، مقاومت ورودی و خروجی در نرمافزار

یادگیری اصول انجام پروژه و اصول گزارشنویسی

کار گروهی

√ متن پروژه

تقویت کنندهای طراحی کنید که دارای مشخصات زیر باشد.

 $(A_{\nu} \ge 10)$:۱۰۰ او بهره ولتاژ بزرگتر از ۱۰۰ ا

 $(R_{in} \ge 10k\Omega)$ اهم: 0 اهم -۲ مقاومت ورودی برابر با

 $(V_{CC}=5V$) : منبع تغذیه ثابتی که در دسترس است ۵ ولت میباشد.

راهنمایی (روش طراحی):

- جهت طراحی می توانید مراحل زیر را قدم به قدم انجام دهید:
- ۱- با توجه به بهره ولتاژ و مقاومت ورودی نوع تقویت کننده (CE, CC, CB, ED) را مشخص کنید.
 - ۲- با توجه به مقاومت ورودی، جریانی برای ترانزیستور فرض نمایید.
 - ۳- با توجه به بهره ولتاژ و جریان، مقاومت کلکتور را بهدست آورید.
- * با توجه به قسمت ۲، مقاومت امیتر را تعیین کنید. توجه کنید که معمولا به جهت پایداری نقطه کار، مقاومت امیتر را طوری تعیین می کنند که ولتاژ دو سر مقاومت امیتر حداقل از $0.1 \times V_{cc}$ بیشتر باشد (سوال ۱: چرا؟). (همچنین حداکثر مقاومت امیتر با توجه به شرط سویینگ مشخص می شود که در اینجا شرطی برای سویینگ نداریم)
- ۵- با توجه به جریان ترانزیستور، مقاومتهای بیس را بهدست آورید. توجه کنید که مقاومتهای بیس باید طوری تعیین شود که شرط پایداری نقطه کار رعایت شود و از جریان بیس بشود صرفنظر کرد. (راهنمایی: دراین صورت جریان شاخه بایاس را میتوانید حدود ۰/۱ جریان کلکتور فرض کنید (سوال ۲: چرا؟))
- ۶- پس از برآوردهشدن تمامی ویژگیها، اکنون نوبت بهینهسازی طراحی است. توجه فرمایید که در طراحی، هر
 چه توان مصرفی منبع تغذیه کمتر باشد، طراحی بهتر است. لذا به گام دوم رجوع کرده و سعی کنید طراحی را
 با جریانهای کمتر مجددا انجام دهید.

در گزارش خود موارد زیر را گام به گام انجام داده و با توضیحات کافی گزارش دهید:

تمرین اول: روش طراحی با ذکر مقادیر عددی. درصورتی که برای طراحی مجبور شدید چندین بار مراحل قبل را تکرار کنید، تنها مقادیر نهایی را ذکر کنید.

تمرین دوم: نقطه کار، بهره ولتاژ تقویت کننده، مقاومت ورودی تقویت کننده و مقاومت خروجی آن را توسط شبیه سازی به دست آورده و آن را با تئوری مقایسه کرده و در یک جدول خلاصه کنید. در صورت تناقض علت را توضیح دهید. نحوه به دست آوردن هر کدام از این پارامترها در نرمافزار را توضیح دهید.

تمرین سوم: سویینگ خروجی را از هم از طریق تحلیل تئوری و هم از شبیه سازی به دست آورده و مقایسه کنید. چه عواملی سویینگ را محدود می کند؟

تمرین چهارم: طراحی خود را تغییر دهید به گونهای که سویینگ خروجی حداکثر حاصل شود.

تمرین پنجم: با اعمال سیگنال سینوسی با دامنه ۱۰ میلیولت و فرکانس ۱۰ کیلوهرتز، خروجی را رسم کرده و THD سیگنال خروجی را به دست آورید.

تمرین ششم: قسمت ۳ را با فرض دامنه ۳۰۰ میلیولت تکرار نمایید. چه تغییری در سیگنال خروجی و THD مشاهده میکنید؟ توجیه نمایید.

موفق، پیروز و سربلند باشید – محمدرضا اشرف